

Ионное наслаивание наноразмерных пленочных структур на основе сульфидов самария

Галковский Т. В. (Foreign), 1,

Богомазова Н. В. (Foreign) 2,

Мурашкевич А. Н. (Foreign) 3,

Захлебаева А. И. 4,

Горох Г. Г. 5

2018

1, 2, 3 Foreign

4, 5 НИЧ, НИЛ 4.10, Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

Ключевые слова: Сульфидные пленки, гетероструктуры, ионное
наслаивание.

Аннотация:

Определены оптимальные режимы формирования однородного функционального покрытия SmS_x методом многократного ионного наслаивания на поверхности низкопрофильных матриц анодного оксида алюминия на кремниевых пластинах. Безградиентная генерация термоЭДС в профилированных матричных пленках $\text{SmS}_x/\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Si}$ толщиной 0,5-1,5 мкм начинается при температуре около 150°C . Значения коэффициента Зеебека в интервале температур $150\text{-}170^\circ\text{C}$ составили около 400 мкВ/К .

Источник публикации: Наноструктуры в конденсированных средах: сборник научных статей. – 2018. – С. 189-194.